

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ПЛАЗМА ТМ200-02

Назначение: Глубокое плазмохимическое анизотропное травление кремния в производстве МЭМС, НЭМС, сборок 2,5D и 3D, а так же сквозных высокоаспектных отверстий и др. на базе Bosch-процесса.



Особенности:

- Индивидуальная и групповая обработка подложек на подложкодержателе в одном технологическом цикле: 60x48 мм – 7 шт.; \varnothing 76мм – 4 шт.; \varnothing 100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе манипулятора;
- Нагрев стенки реактора до 60°C;
- Гелиевое охлаждение и механический прижим пластин;
- Рабочие газы: Ar, SF₆, O₂, C₄F₈, He.;
- Скорость анизотропного травления кремния не менее 5 мкм/мин;
- Попеременная подача газа с программируемым временем цикла;
- Мощность потребления не более 19 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

